



FSSI
Research Report

Kanazawa University

2021. 5

Topic



2021 年度 科研費の採択傾向

本年度の科学研究費助成事業の交付内定が去る 4 月 1 日に日本学術振興会より行われました。
本学からは約 300 名の方が採択されました。

本学の採択率

現時点において、基盤研究 (A)、(B)、(C)、若手研究、
新学術領域研究の 5 種目について交付内定が行われて
います。

応募数：736 件

採択数：299 件 (5 種目での採択率：40.6%)

種別では、若手研究の採択率が 48.9% と最も高く、全
種別において国内全体の採択率を上回っていました。
本年度は、基盤研究 (A) の採択率が 47.1% (昨年は
15.8%)、基盤研究 (B) が 41.9% (昨年は 26.4%) と
なっており、昨年よりも大きく採択率が上昇しました。
国内全体の採択率と比較しても 2 割ほど高い傾向に
ありました (図 1)。

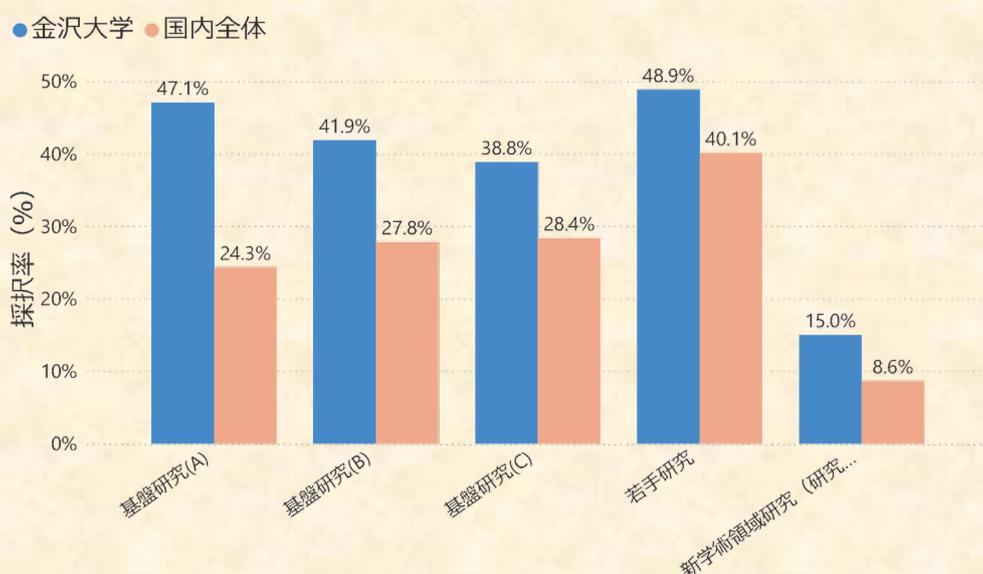
基盤研究 (B) の採択傾向

本年度の基盤研究 (B) の採択率上昇の要因としては、

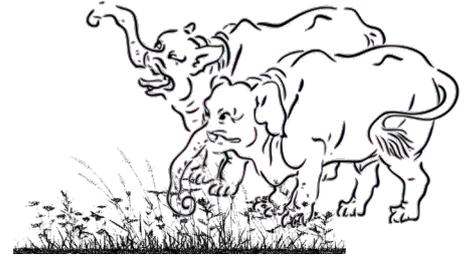
- 基盤研究 (B) に過去初めて採択された人が増加
- 若手研究からのステップアップした人が増加
が挙げられます。

基盤研究 (B) の内定者 54 名の約 4 割 (昨年は 1 割程
度) が、過去に基盤研究 (B) の採択履歴の無い人でし
た。さらにその中で、過去に基盤研究 (C) の採択履歴
が無い人が 4 割 (8 名) いました。

図 1. R3 年度科学研究費助成事業の種目別の採択率



Topic



次年度の基盤研究 (B) の採択に向けて、初めて基盤研究 (B) に採択された人の過去の採択履歴について分析を行いました。その結果、若手研究からのステップアップには新学術領域研究の採択履歴が関係していました。

基盤研究 (B) 内定者の採択履歴 (図 2)

初めて基盤研究 (B) に採択された人 (20 名) の過去の種別ごとの平均採択回数は、

- 基盤研究 (B) : 0 回
- 基盤研究 (C) : 1.1 回
- 若手研究 : 1.5 回
- 新学術領域研究 (提案型) : 0.5 回

その中でも基盤研究 (C) の採択歴が無い人 (8 名) の種別ごとの平均採択率は、

- 基盤研究 (B) : 0 回
- 基盤研究 (C) : 0 回
- 若手研究 : 1.4 回
- 新学術領域研究 (提案型) : 0.9 回

でした。

基盤研究 (B) の申請にむけて

過去の採択履歴の傾向より、基盤研究 (B) に新たに挑戦する場合には、

若手研究に 1~2 回の採択履歴があり、かつ

○ 基盤研究 (C) が 1 回以上

もしくは

○ 新学術領域研究 (提案型) が 1 回以上

の採択履歴があるときに、基盤研究 (B) に挑戦する最適な時期になりそうです。

本年の科研費申請対象者 (539 名) の内、過去に基盤研究 (B) に採択されたことがなく、若手研究に 1~2 回の採択履歴があり、「かつ基盤研究 (C) に 1 回以上の採択履歴がある人」は **154 名**、または「かつ新学術領域研究 (提案型) に 1 回以上の採択履歴がある人」は **17 名** (内 3 名は基盤研究 (C) の採択歴なし) が該当します。

本年度の応募の注意点

科研費の申請スケジュールが前倒しされています。昨年よりもおよそ 1 箇月程度、申請が早まっていますのでご注意ください。詳しいスケジュールは、[学術振興会のホームページ](#)をご確認ください。

図 2. 過去に基盤研究 (B) の採択履歴のない内定者 (基盤研究 (B)) の科研採択平均回数

	基盤研究 (B)	基盤研究 (C)	若手研究	新学術領域研究 (提案型)
本年度に初めて基盤研究 (B) に採択された人 (20 名)	/	1.1	1.5	0.5
さらにその内、 基盤研究 (C) の採択履歴が無い人 (8 名)	/	/	1.4	0.9



研究者紹介

論文ピックアップ

本学の「[Papers of the Month](#)」に選ばれた最新の論文を紹介します。

ナノマテリアル研究所：省エネデバイス開発グループ

「世界初：ダイヤモンド-on-シリコン技術を用いてヘテロエピタキシャルダイヤモンド反転層チャンネル MOSFET を開発！」



張 旭芳
特任助教



松本 翼
准教授

ダイヤモンド MOSFET の社会実装にはダイヤモンド基板の大面积化が大きな課題の一つです。

今回、一般的な半導体デバイスに用いられている単結晶シリコン基板上において、ダイヤモンド膜を成膜（ダイヤモンド-on-シリコン技術）し、そのダイヤモンド自立基板を用いた反転層チャンネル MOSFET の作製および動作実証に世界で初めて成功しました。

これまでに開発してきたダイヤモンド MOSFET と



反転層チャンネル
ダイヤモンド MOSFET

同等のデバイス特性が得られており、ダイヤモンドの大面积化、ダイヤモンド半導体の実用化に向けて大きく前進しました。

掲載雑誌名：「CARBON」(IF = 8.821)

<https://doi.org/10.1016/j.carbon.2020.11.072>

編集者コメント

科学研究費助成事業や外部研究事業等についての情報を分析し、研究者の皆様に広く発信するために、「FSSI Research Report」を毎月発行しています。レポートに記載の分析結果詳細やアーカイブを[ホームページ](#)に掲載していますので、ぜひご覧ください。

ご紹介した「科研費の採択傾向」につきましては、全ての皆様に当てはまるわけではありませんが、基盤研究 (B) に挑戦する時期の一つの目安にいただければと思います。(池田)

リンク一覧

研究支援全般に関する情報

<https://o-fsi.w3.kanazawa-u.ac.jp/>

レポートのアーカイブ

<https://kanazawa-fssi.com/fssi-report/>

FSSI による研究支援

<https://o-fsi.w3.kanazawa-u.ac.jp/researcher/support/>

【お問い合わせ】



金沢大学先端科学・社会共創推進機構 (FSSI)

✉ : kanazawa-fssi-ir@kanazawa-fssi.com



5月25日 白き雲のように咲き誇る学内のヤマボウシ (山法師)